**Влияние частоты поверхности на процесс самоорганизации нанокластеров SiGe**

**Ковалевский А.А.**

**Строгова А.С.**1

**Комар О.М.**

1 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Ковалевский А. А. Влияние частоты поверхности на процесс самоорганизации нанокластеров SiGe / А. А. Ковалевский, А. С. Строгова, О. М. Комар // Сборник трудов Х Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» (Санкт-Петербург, 4-7 июля 2016 г.). - Санкт-Петербург, 2016. - С. 72 - 73.

**Аннотация:** Последовательная абсорбция одного или двух монослоев германия приводит к образованию нанокластеров SiGe, причем вначале наблюдается быстрое формирование первого монослоя SiGe, а затем более медленное формирование, второго и третьего монослоев SiGe. Установлена эволюция изменения рельефа как поверхности после различных типов обработки, так и нанокластеров, на поверхности исходных подложек с изменением условий обработки исходных подложек. Таким образом, степень совершенства поверхности следует рассматривать как существенную часть общей задачи приготовления чистой поверхности перед процессом формирования нанокластеров SiGe и подавления их трансформации от наноразмеров к микроразмерам.

**Ключевые слова:** нанокластеры, кремниевая подложка, монослой SiGe, трансформация размеров

**Интернет – ссылка на статью**

<http://www.ioffe.ru/AMS/AMS10/index.php>